FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (Ta=25°C)					電気的特性 (Ta=25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* (Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10	11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

: とコンプリ : COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C) V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	電気的特性 (T_a = 25°C) I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)	外形	備考
2SB631	三洋	PA	Si. EP	−100	−5	−1A	8 W (Tc=25°C)	150	−1	−50	60~320	−5	−50	−10	50					110*	30		296	2SD600 とコンプリ
〃 632	〃	〃	〃	−25	−5	−2A	10W (Tc=25°C)	150	−1	−20	60~320	−2	−500	−10	50					100*	45		296	2SD612 とコンプリ
〃 633	〃	〃	〃	−100	−6	−6A	40W (Tc=25°C)	150	−100	−40	40~320	−5	−1A	−5	1 A					15*	150		268	2SD613 とコンプリ
★ 〃 634	〃	〃	Si.EMe	−120	−6	−7 A	60W (Tc=25°C)	150	−100	−80	40~320	−5	−1 A	−5	1 A					15*			102	
★ 〃 635	松下	AF	Ge. A	−32	−10	−150	150	85	−12	−10	180	V_{CB} −0.5	−2	−2	3		1.8k	7.5	90	0.7			297	
★ 〃 636	〃	PA	〃	−32	−10	−150	150	85	−12	−10	90	V_{CB} −0.5	−100	−6	1	NF=3dB (f=1kHz, V_{CB}=−2V, I_E=0.5mA)				0.7			297	
〃 637	日立	AF	Si. E	−50	−5	−100	300	125	−0.1	−18	160~800	−12	−2	−12	2					200*	1.8		138	
〃 638	〃	PA	Si.EPa	−100	−7	−10A	80W (Tc=25°C)	150	−100	−100	1000~20000	−3	−5A			t_{on}=2 μS, t_{off}=8 μS							102	ダーリントン
〃 639	〃	〃	〃	−100	−7	−10A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	1000~20000	−3	−5A			t_{on}=2 μS, t_{off}=8 μS							102	ダーリントン
★ 〃 640	松下	〃	Ge. A	−25	−6	−300	150	85	−20	−12	150	V_{CB} −0.5	−150			NF=15dB (f=1kHz, V_{CB}=−6V, I_E=5mA)							297	
〃 641	〃	〃	Si. EP	−30	−5	−100	400	135	−1	−20	200	−10	−2	−5	2	150	3 k	3	50	120*	3.5	100	151	
〃 642	〃	〃	〃	−60	−5	−100	400	135	−1	−20	200	−10	−2	−5	2	150	3 k	3	50	120*	3.5	100	151	
〃 643	〃	〃	〃	−30	−7	−500	600	135	−0.1	−20	160	−10	−10	−10	50					200*	6	3.5k*	151	2SD638 とコンプリ
〃 644	〃	〃	〃	−60	−7	−500	600	135	−0.1	−20	160	−10	−10	−10	50					200*	6	3.5k*	151	2SD639 とコンプリ
〃 645	東芝	〃	Si.TMe	−200	−5	−15A	150W (Tc=25°C)	150	−100	−100	40~140	−5	−1A	−10	1 A					12*	450		102	2SD665 とコンプリ
〃 646	日立	〃	Si. E	−120	−5	−50	900	150	−10	−100	60~320	−5	−10	−5	10					140*	4		251	2SD666 とコンプリ
〃 647	〃	〃	〃	−120	−5	−1A	900	150	−10	−100	60~320	−5	−150	−5	150					140*	20		251	2SD667 とコンプリ
〃 648	〃	〃	〃	−180	−5	−50	1 W	150	−10	−160	60~320	−5	−10	−10	10					140*	4.5		160	2SD668 とコンプリ
〃 649	〃	〃	〃	−180	−5	−1.5A	1 W	150	−10	−160	60~320	−5	−150	−5	150					140*	27		160	2SD669 とコンプリ
〃 650	〃	〃	Si.EPa	−100	−7	−15A	100W (Tc=25°C)	150	−100	−100	1000~20000	−3	−8A			t_{on}=2 μS, t_{off}=8 μS							102	ダーリントン
〃 651																								
〃 652																								
★ 〃 653	日立	PA	Si. T	−120	−5	−7A	60W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A										102	2SD673 とコンプリ
★ 〃 654	〃	〃	〃	−120	−5	−7A	80W (Tc=25°C)	150	−1mA	−100	60~200	−5	−1A										102	2SD674 とコンプリ
★ 〃 655	〃	〃	〃	−160	−5	−12A	100W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60~200	−5	−1A										102	2SD675 とコンプリ
★ 〃 656	〃	〃	〃	−160	−5	−12A	125W (Tc=25°C)	150	−1mA	−140	60~200	−5	−1A										102	2SD676 とコンプリ
〃 657																								
〃 658																								
〃 659																								
〃 660																								